



## Galliumarsenid-Lumineszenzdioden GaAs Infrared Emitting Diodes

**Anwendung:** Strahlungsquelle im nahen Infrarot-Bereich

**Application:** Radiation source in near infrared range

### Besondere Merkmale:

- Kunststoffgehäuse
- Hohe Strahlstärke
- Hoher Strahlungsfluß
- Für Impulsbetrieb geeignet
- Gute spektrale Anpassung an Silizium-Fotoempfänger

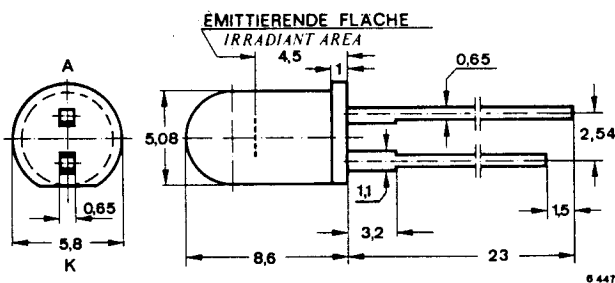
### Features:

- Plastic case
- High radiant intensity
- High radiant power
- Suitable for pulse operation
- Good spectral matching for silicon photo detectors

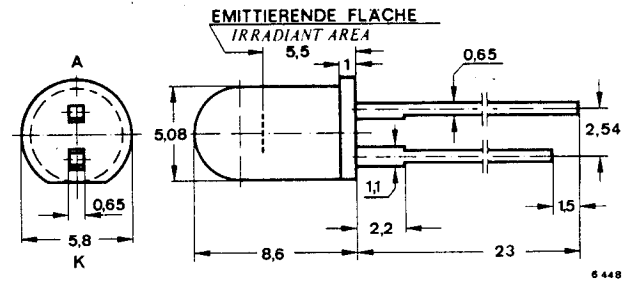
### Vorläufige technische Daten · Preliminary specifications

**Abmessungen in mm**

**Dimensions in mm**



**CQY 98**



**CQY 99**

Abstrahlwinkel  
Angle of half intensity

**CQY 98**  $\alpha = 40^\circ$

**CQY 99**  $\alpha = 60^\circ$